

# 日本電子材料技術協会 第55回秋期講演大会プログラム

2018年11月8日

社団法人日本セラミックス協会 3階会議室

協催 先進コーティングアライアンス

開会の辞 会長 明渡 純 (産業技術総合研究所)

<< 午前の部 >>

座長：小西幸宏 (太陽誘電 (株))

- A1 9:30-9:45 透過型電子顕微鏡による AlN 薄膜の粒界構造解析  
◎山藤知徳、龍穰、岩崎誉志紀  
太陽誘電 (株)
- A2 9:45-10:00 直流アークプラズマを用いるイオンプレーティングにより作製した  
高 c 軸配向 AlN 薄膜  
◎野本淳一<sup>1</sup>、北見尚久<sup>2</sup>、牧野久雄<sup>3</sup>、山本哲也<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>産業技術総合研究所、<sup>2</sup>住友重機械工業 (株)、<sup>3</sup>高知工科大学
- A3 10:00-10:15 誘電体界面の導入による Li イオン電池の出力改善  
○寺西貴志、吉川祐未、岸本 昭  
岡山大学
- A4 10:15-10:30 集光炉を用いた熔融法による新規赤色蛍光体の合成  
○勝峰徳<sup>1</sup>、武藤 雅<sup>1</sup>、上松和義<sup>1</sup>、戸田健司<sup>1</sup>、佐藤峰夫<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>新潟大学院、<sup>2</sup>新潟大学
- A5 10:30-10:45 サイトエンジニアリング現象を用いた白色 LED 用蛍光体の開発  
◎岩城将人、上松和義、戸田健司、佐藤峰夫  
新潟大学
- 10:45-10:55 . . . . . 休憩 . . . . .

座長：今中佳彦 ((株) 富士通研究所)

- A6 10:55-11:10 環境・エネルギー分野への適用を目的とした金属-有機構造体の開発  
○眞鍋敏夫、今中佳彦  
(株) 富士通研究所
- A7 11:10-11:25 SPS 法により作製した Eu 添加 CsBr 透光性セラミックスの放射線  
誘起蛍光特性  
◎木村大海、加藤 匠、中内大介、河口範明、柳田健之  
奈良先端科学技術大学院大学

- A8 11:25-11:40 Yb 添加 YA10<sub>3</sub> 単結晶のシンチレーション特性  
◎赤塚雅紀、河口範明、柳田健之  
奈良先端科学技術大学院大学
- A9 11:40-11:55 スパッタリングを用いた水電解用電極触媒の開発  
◎吉永典裕、金井佑太、深沢大志、中野義彦、梅武  
(株) 東芝
- A10 11:55-12:10 自己発熱型 CO<sub>2</sub> 吸収コンポジット Si/SiO<sub>x</sub>/Li<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> の作製および  
CO<sub>2</sub> 吸収・放出挙動の評価  
大石克嘉<sup>1</sup> ◎草野大志<sup>1</sup> 石寄友己<sup>1</sup> 岡 研吾<sup>1</sup>、小林亮太<sup>2</sup>、真島 豊<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>中央大学、<sup>2</sup>東京都市大学、<sup>3</sup>東京工業大学
- 12:10-13:00 . . . . . 昼食休憩 . . . . .

<< 午後の部 >>

座長：島村清史（物質・材料研究機構）

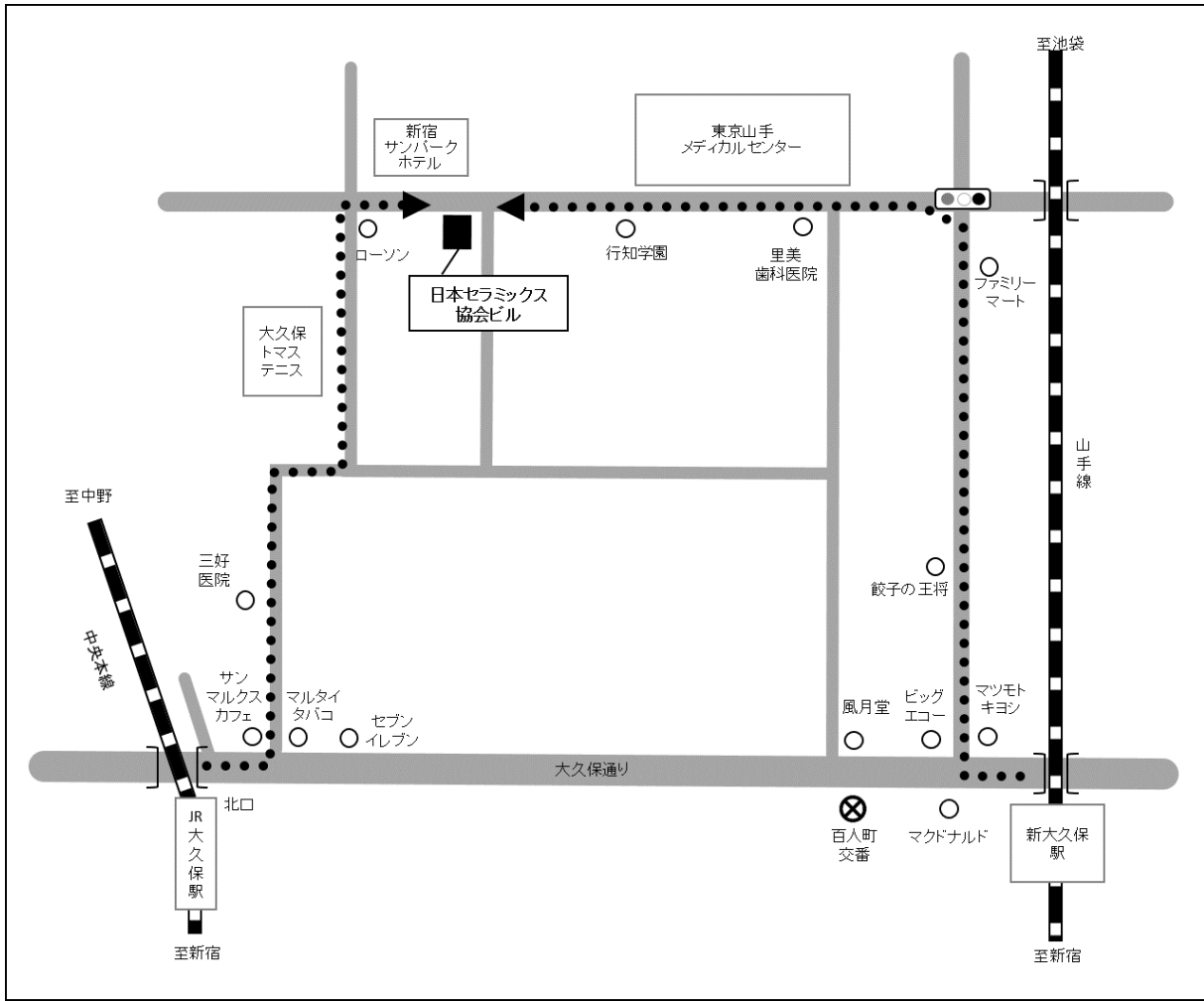
- P1 13:00-13:15 耐熱・耐酸化性(Ba, Sr)RuO<sub>3</sub> 導電性セラミックスの焼結と薄膜電極  
への応用  
○野口祐二<sup>1</sup>、多田 大<sup>2</sup>、北中佑樹<sup>1</sup>、槇恒<sup>1</sup>、宮山 勝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京大学、<sup>2</sup> 東京工業大学
- P2 13:15-13:30 多層バッファーを利用した BaTiO<sub>3</sub> 強誘電体薄膜キャパシタ  
○野口祐二、槇恒、北中佑樹、松尾拓紀、宮山 勝  
東京大学
- P3 13:30-13:45 BaTiO<sub>3</sub>-(Bi<sub>1/2</sub>K<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub> 系半導体セラミックスの作製と粒界の電氣的  
特性  
○武田博明<sup>1</sup>、Mohammed A. Zubair<sup>2</sup>、保科拓也<sup>1</sup>、鶴見敬章<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京工業大学物質理工、<sup>2</sup>バンガラデシュ工科大
- P4 13:45-14:00 ナノパーティクルデポジション膜の誘電特性および寿命予測  
○天田英之、熊坂文明、今中佳彦  
(株) 富士通研究所
- P5 14:00-14:15 NPD 成膜による WO<sub>3</sub> 電極の光電特性  
○穴澤俊久、眞鍋敏夫、天田英之、熊坂文明、今中佳彦  
(株) 富士通研究所
- 14:15-14:25 . . . . . 休憩 . . . . .

座長：秋本順二（産業技術総合研究所）

- P6 14:25-14:40 (Bi, Na)TiO<sub>3</sub>系ペロブスカイトの不定比性と Morphotropic 相境界  
◎野元 颯、北中佑樹、野口裕二、宮山 勝  
東京大学大学院
- P7 14:40-14:55 微細結晶化によるビスマス層状構造強誘電体の誘電特性の改善  
○鈴木宗泰、土屋哲男、明渡 純  
産業技術総合研究所
- P8 14:55-15:10 プロトンビーム照射によるチタン酸ビスマス膜の改質効果  
○平出 惇<sup>1</sup>、山崎美沙<sup>1</sup>、山口正樹<sup>1</sup>、増田陽一郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>芝浦工業大学、<sup>2</sup>八戸工業大学
- P9 15:10-15:25 Fast preparation of homogenous VO<sub>2</sub> thin films at low temperature.  
◎Gabrielle Bordelet, Iwao Yamaguchi, Takaaki Manabe,  
Tetsuo Tsuchiya  
AIST
- P10 15:25-15:40 サブ MeV イオン照射による酸化物超電導薄膜の高特性化  
○松井浩明、大塚照久、小木曾久人、山崎裕文、相馬 貢、山口 巖、  
熊谷俊弥、真部高明  
産業技術総合研究所
- 15:40-15:50 . . . . . 休憩 . . . . .

座長：原田耕一（(株) 東芝）

- I-1 15:50-16:30 特別講演 1  
元素ドーピングによる窒化アルミニウム薄膜の圧電性の向上  
秋山守人 氏 産業技術総合研究所
- I-2 16:30-17:10 特別講演 2  
高周波無線通信技術を支える LTCC 材料・プロセス技術  
杉本安隆 氏 (株) 村田製作所
- I-3 17:10-17:50 特別講演 3  
Nd:YAG レーザーを用いたセラミックスの短時間焼結技術  
木村禎一 氏、末廣 智 氏  
日本ファインセラミックスセンター
- 閉会の辞 副会長 島村清史（物質・材料研究機構）
- 18:00 表彰式および自由討論会（サンパークホテル）



住所：169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 (社) 日本セラミックス協会ビル